

RAZTAPLJANJE SILICIJA V PODEVTEKTI^NI TIKSOTROPNI MEĀNICI AI-Si

DISSOLVING OF SILICON IN AN HYPOEUTECTIC THIXOTROPIC MIXTURE AI-Si

GORAZD LOJEN, I. AN@EL, A. KRI@MAN

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor

Prejem rokopisa - received: 1997-10-01; sprejem za objavo - accepted for publication: 1997-12-19

Razvili smo model postopka izdelave kompozitov s "sintezo tiksotropnih meānic". Postopek rešuje problem omo-ljivosti in hkrati omogo-a variiranje dele'ev posameznih faz v kompozitu. Obsega tri korake: izdelavo izhodnih tiksotropnih meānic, sintezo izhodnih dvoafaznih tiksotropnih meānic v kompozitno meānico in strjevanje. Tako izdelani kompoziti v sploinem vsebujejo termodinamsko nekompatibilne primarne faze, ki so neposredno po sintezi, preden se kompozit strdi, nestabilne, in te'ijo k hitremu razpadu. V prispevku so predstavljeni izsledki (studija razapljanja Si v povevtekti-ni tiksotropni meānici AI-Si). Klju-ne besede:kovinski kompoziti AI-Si, sinteza tiksotropnih meānic, razapljanje Si

A processing model for the production of metal matrix composites by the "synthesis of thixotropic mixtures" was developed. By this process the problem of wettability is solved and variations of the phase fractions in the composite are enabled. The process includes three steps: preparation of precursive thixotropic mixtures, the synthesis of the precursive two - phase thixotropic mixtures into a composite one, and its solidification. Composites, produced by this process, generally contain thermodynamically incompatible primary phases, which tend to disintegrate before the composite is solidified. In this paper the results of our study of dissolving of Si in an hypoeutectic thixotropic Al-Si mixture are presented.

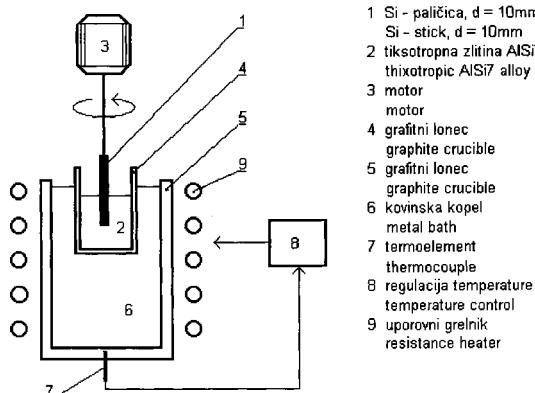
Key words: metal matrix composites, synthesis of thixotropic mixtures, dissolving of Si

1 UVOD

Po postopku "sinteze tiksotropnih meānic"¹) smo izdelali dve kompozitni meānici: povevtekti-no, AISi10 in nadvtekti-no, AISi20. Mikrostrukturi obeh vsebujeta α_{Al} , primarni Si ter evtektik. Izhodni tiksotropni meānici sta bili v obeh primerih zlitini AISi7 in AISi40.

Za uspeeno proizvodnjo tak{nih kompozitov v ve-jem obsegu, in seveda tudi za njegovo prakti-no uporabnost (npr. tikso-litje in tikso-kovanje), je klju-nega pomena obstojnost primarnih trdnih faz v temperaturnem obmo-ju med T_s in T_L kompozitne meānice.

Cilj v nadaljevanju prispevka opisanih eksperimentov je bil ugotoviti hitrost razapljanja Si - kristalov v teko-i fazi AI-Si ob prisotnosti trdne faze α_{Al} .



Slika 1: Eksperimentalna naprava
Figure 1: Experimental device

2 IZVEDBA EKSPERIMENTOV

Hitrost razapljanja primarnih faz smo ugotavljali z modelnim eksperimentom. Eksperimentalno napravo prikazuje slika 1.

Rotirajo-o silicijevo pali-ico s premerom 10 mm smo potopili v delno staljeno ($\alpha + L$) tiksotropno zlitino AISi7. Na osnovi izgube mase Si - pali-ice smo ocenjevali hitrost razapljanja Si v razmerah prisilne konvekcije. Hkratna rotacija Si - pali-ice okoli lastne osi in po obodu lon-ka je zagotavljala dobro meāanje in izena-evanje koncentracije Si v tiksotropni zlitini AISi7.

3 REZULTATI

Rezultati poskusov, izvedenih pri razli-nih temperaturah tiksotropne zlitine AISi7 z rotirajo-o in mirujo-o silicijevo pali-ico, so zbrani v tabeli 1.

Tabela 1: Hitrost razapljanja silicia v tiksotropni zlitini AISi7
Table 1: Dissolving rate of silicon in the thixotropic AISi7 alloy

T (°C)	585	590	600	610	590*
Δt (s)	300	300	300	180	630
Δm (g)	2,5	6,0	6,6	7,3	1,1
$\frac{\Delta m}{\Delta t \cdot A} \left[\frac{g}{s \cdot mm^2} \right]$	$9,7 \cdot 10^{-6}$	$2,2 \cdot 10^{-5}$	$2,3 \cdot 10^{-5}$	$4,7 \cdot 10^{-5}$	$1,8 \cdot 10^{-6}$
$\frac{\Delta m}{\zeta \Delta t \cdot A} \left[\frac{\mu m}{s} \right]$	4,2	9,4	10,0	20,0	0,8

T (°C) - temperatura tiksotropne zlitine AISi7 / temperature of the thixotropic AISi7 alloy

Δt (s) - raztopljanje / dissolving time

Δm (g) - raztopljena količina Si / dissolved amount of Si
 A (mm^2) - povprečna kontaktna površina Si pali-ice s tiksotropno zlitino AISi7 / average contact surface of the silicon stick and thixotropic AISi7 alloy

$\frac{\Delta m}{\Delta t \cdot A}$ $\left[\frac{\text{g}}{\text{s} \cdot \text{mm}^2} \right]$ - hitrost raztopljanja / dissolving rate

$\frac{\Delta m}{\zeta \cdot \Delta t \cdot A}$ $\left[\frac{\mu\text{m}}{\text{s}} \right]$ - debelina plasti, ki se raztopi v ~asovni enoti / thickness of layer, dissolved in unit of time

ς $\left[\frac{\text{g}}{\text{mm}^3} \right]$ - gostota silicija / density of silicon

* - mirujoča pali-ica / no rotation

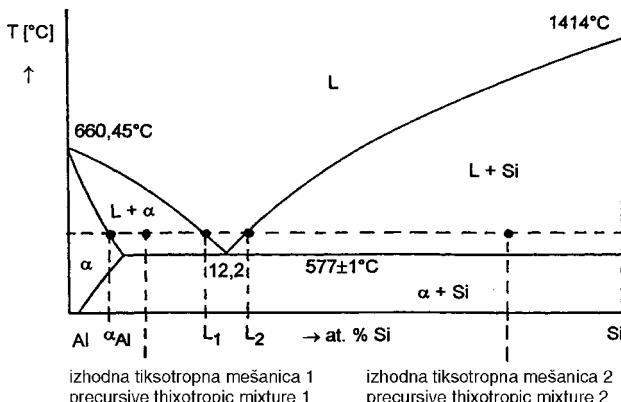
4 DISKUSIJA

V realnih razmerah izdelave kompozitne trofazne mešanice po postopku "sinteze tiksotropnih mešanic" poteka proces raztopljanja primarnih trdnih faz v tekoči fazi nekoliko drugače kot pri izvedenih modelnih poskusih.

V realnih razmerah delci primarnih trdnih faz niso prekriti z oksidno plastjo, ki bi ovirala za-tek raztopljanja, saj se izločajo iz talin med ohlajanjem izhodnih zlitin v dvofazno področje. Modelni poskus pa je izveden s samo eno tiksotropno zlitino (podevtektino zlitino AISi7) in z ulito silicijevo pali-ico. Pali-ica je kljub bručenju neposredno pred izvedbo poskusa prekrita s tanko oksidno plastjo, razen tega pa ima pred potopitvijo temperaturo okolice. Oboje povzroči zakasnitev za-teka raztopljanja.

Sestava tekoče faze (slika 2) je neposredno pred za-tekom raztopljanja pri modelnem poskusu drugačna kot v realnih razmerah. Pri teh je sestava tekoče faze L nekje med L_1 in L_2 . Lahko jo natančno ugotovimo, saj poznamo količino in sestavo tekočih faz L_1 in L_2 v izhodnih tiksotropnih zlitinah. Pri modelnem poskusu pa ima tekoča faza pred za-tekom raztopljanja sestavo L_1 .

Kako vpliva za-tečna sestava tekoče faze na potek raztopljanja primarnih trdnih faz, bo potrebno pojasniti z nadaljnji raziskavami.



Slika 2: Sestava tekoče faze

Figure 2: Composition of the liquid phase

Pri prisilni konvekciji hitrost raztopljanja kontrolira kinetika prehajanja atomov iz trdnih delcev v talino².

V termodinamsko nestabilni mešanici, ki je sestavljena iz α_{Al} , primarnega Si in tekoče faze Al-Si, se hkrati raztopljuje obe primarni trdni fazi, hitrost procesa pa je odvisna od tiste trdne faze, pri kateri je transport mase skozi mejno plast trdno - tekočo po-asnejši. Aluminij se struje nefasetirano in ima ničjo talilno entropijo kot silicij, ki kristalizira fasetirano, zato lahko njegovi atomi hitreje prehajajo v talino kot silicijevi.

Zelo verjetno je, da se v realnih razmerah delci α_{Al} v prvi fazi procesa raztopljuje hitreje kot primarni Si - kristali, sestava tekoče faze pa se za-ne spremeni. Koncentracija Al v tekoči fazi narašča, dokler ta ne doseže neke "ravnote'ne" sestave blizu mejne vrednosti L_1 . Od tega trenutka naprej kontrolira hitrost raztopljanja oba primarnih trdnih faz silicij, saj se lahko razaplja samo že toliko aluminija, kot je potrebno za ohranjanje dose'ne "ravnote'ne" sestave tekoče faze.

Pri izvedenih modelnih poskusih ima tekoča faza za-tečno sestavo L_1 , zato domnevamo, da se sestava tekoče faze med raztopljanjem le nebistveno spremeni in je hitrost raztopljanja oba primarnih trdnih faz ves ~enaka.

Neposredni rezultat izvedene serije modelnih poskusov je količina silicija, ki se je raztopila v določenem ~asu. Na osnovi tega pa že ni mogoče sklepati o trajnosti primarnih trdnih delcev v kompozitni tiksotropni mešanici. Za napovedovanje njihove trajnosti je potrebno poznati, razen velikosti in oblike primarnih trdnih delcev, že hitrost njihovega raztopljanja, izraženo npr. kot izguba mase v ~asovni enoti na enoto površine, $\text{g}/(\text{s} \cdot \text{mm}^2)$, ali kot debelino plasti, ki se raztopi v ~asovni enoti, $\mu\text{m}/\text{s}$. V tabeli 1 so zbrane na oba načina izražene hitrosti raztopljanja silicija.

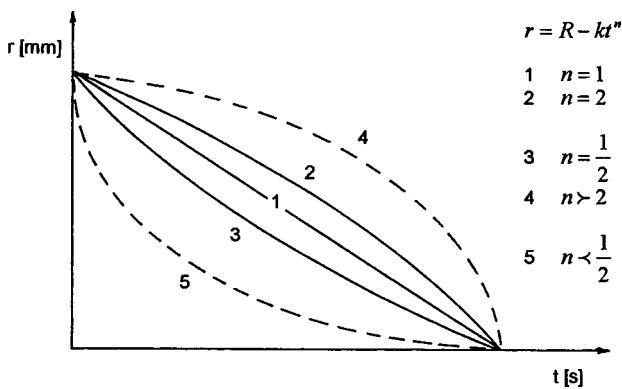
Izračun hitrosti raztopljanja je temeljal na več predpostavkah in poenostavitevah:

- 1) Raztopljanje Si - pali-ice se za-ne tako, ko jo potopimo v tiksotropno zlitino AISi7, brez zakasnitive



Slika 3: Oblika silicijeve pali-ice med raztopljanjem

Figure 3: Shape of the silicon stick during dissolution



Slika 4: Shemati-ni prikaz razli-nih hipoteti-nih funkcij r(t)
Figure 4: Schematic presentation of different hypothetical r(t) functions

2) hitrost raztplavljanja je ves ~as poskusa konstantna (sestava teko-e faze se med poskusom ne spreminja, saj se hkrati raztplljata Si - pali-ica in trdni delci α_{Al} , dobro me{anje pa zagotavlja konstanten koncentracijski gradi{ent)

3) oblika Si - pali-ice se zaradi njenega raztplavljanja spreminja iz valja najprej v prisekan sto'ec, nato pa v koni-ast sto'ec; dokler ima potopljeni del pali-ice obliko prisekanega sto'ca, je sprememb dol'ine zanemarljiva - pali-ica se za-ne kraj{ati {ele, ko postane sto'asti konec koni-ast, **slika 3**.

Hitrost raztplavljanja smo definirali z izrazom:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t \cdot A} \quad (1)$$

Kontaktna povr{ina A se spreminja s ~asom, zato na velikost povpre-ne kontaktne povr{ine vpliva funkcija odvisnosti kontaktne povr{ine \bar{A} od ~asa t.

Ob upo{evanju predpostavke 3), da ima Si - pali-ica obliko prisekanega sto'ca, je kontaktna povr{ina enaka:

$$A(t) = \pi \cdot \sqrt{h^2 + (R-r(t))^2} \cdot (R+r(t)) + \pi \cdot r^2(t) \quad (2)$$

mejni vrednosti radija prisekanega sto'ca pa sta:

$$r = R \text{ v ~asu } t = 0 \text{ in}$$

$$r = r_k \text{ v ~asu } t = \Delta t$$

Natan~no vrednost povpre-ne kontaktne povr{ine lahko izra-unamo v tem primeru z numeri-no integracijo ena-be (2), po ena-bi (3):

$$\bar{A} = \frac{\int_{t=0}^{t=\Delta t} A(t) dt}{\Delta t} \quad (3)$$

Preprostej{i, vendar manj natan~en je izra-un po ena-bi (4), pri katerem ni potrebno poznati funkcije A(t) oz. r(t):

$$\bar{A} = \frac{A_0 + A_k}{2} \quad (4)$$

kjer sta A_0 kontaktna povr{ina na za-etu raztplavljanja in A_k kontaktna povr{ina ob koncu poskusa.

Ker funkcija r(t) v na{em primeru ni znana, smo v izra-unih hitrosti raztplavljanja, podanih v **tabeli 1**, upo{tevali povpre-ne kontaktne povr{ine, izra-unano po ena-bi (4).

Da bi lahko ocenili natan~nost teh izra-unov, smo za primerjavo izra-unali tudi povpre-ne kontaktne povr{ine po ena-bi (3) za razli-ne hipoteti-ne ~asovne odvisnosti radija prisekanega sto'ca, in sicer:

- za linearne (**slika 4**, krivulja 1) $r = R - k_1 \cdot t$,
- za kvadratne (**slika 4**, krivulja 2) $r = R - k_2 \cdot t^2$ in
- korenko (**slika 4**, krivulja 3) $r = R - k_3 \cdot \sqrt{t}$.

Bistveno druga-ne funkcija odvisnosti bi bile verjetne le, ~e bi se hitrost raztplavljanja med procesom mo-no spremnjala.

V{je potence n v izrazu $r = R - kt^n$ bi namre-pomenile, da raztplavljanje v za-etu poskusa poteka zelo po-asi, proti koncu pa zelo hitro (**slika 4, krivulja 4**), ni' je pa, da je hitrost raztplavljanja zelo velika na za-etu in zelo majhna proti koncu raztplavljanja (**slika 4, krivulja 5**). Ker se med raztplavljanjem razmre prakti-no ne spremnjajo in ostajajo parametri, ki vplivajo na hitrost raztplavljanja (koncentracijski gradient ΔC in koeficient prehoda snovi K) konstantni, tak{no spremjanje hitrosti raztplavljanja ni realno.

Hitrosti raztplavljanja, izra-unane z upo{evanjem povpre-ne kontaktne povr{ine po ena-bi (3), se od tiste, izra-unane z upo{evanjem ena-be (4), razlikujejo od +5% do najve- -16% (pri korenko odvisnosti radija od ~asa). To ka'e, da ob vseh upo{evanih predpostavkah na-in dolo-anja povpre-ne kontaktne povr{ine v uporabljeni metodi izra-una hitrosti raztplavljanja silicija le malo vpliva na zanesljivost rezultata.

5 SKLEP

Hitrosti raztplavljanja v **tabeli 1** so orientacijske vrednosti, s katerimi lahko ocenimo trajnost trdnih primarnih faz v kompozitni trofazni me{anicah in ~as, ki je na voljo za izdelavo le - te, pod pogojem, da dovolj natan~no poznamo za-etno velikost in obliko primarnih trdnih delcev.

Za zanesljivej{e ocene trajnosti primarnih trdnih delcev v trofaznih kompozitnih me{anicah Al - Si bo potrebno z nadaljnjjim {tudijem in eksperimenti natan~neje ovrednotiti, tako predpostavke, na katerih temeljijo izvedeni izra-uni, kakor tudi rast primarnih faz med ogrevanjem in zadr' evanjem izhodnih tiksotropnih me{anic v dvofaznem podro-ju.

6 LITERATURA

¹G. Lojen, I. An'el, A. Kri'man: Sinteza tiksotropnih me{anic, Dru{vo livarjev Slovenije, 38. liversko posvetovanje, zbornik referatov, (1997) 212-224

²D. E. Langberg, M. Nilmani: The production of nickel - zinc alloys by powder injection, *Metallurgical and materials transactions B*, 27B (1996) 781-787

³ D. Apelian, R. O'Malley, C. Dremann: *Proc. Scaninject II*, Mefos and Jernkontoret, Lulea, Sweden, (1980) pp. 7:1-7:33

⁴ D. E. Langberg, C. Fan, M. Nilmani: *Proc. 2nd Australian Asian Pacific course: Melt treatment and casting*, The University of Melbourne, Australia, 1-4 July, 1991, pp. 16:1-16:11

⁵ W. Kurz, D. J. Fisher: *Fundamentals of solidification*, third edition, Trans tech publications, Switzerland - Germany - UK - USA, 1989